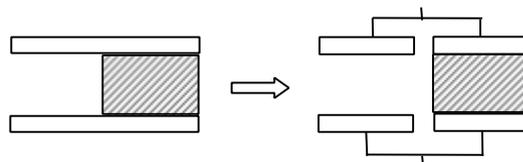


## 电容 静电场中的能量

1. 如图, 该平行板电容器可等效为两平行板电容器  $C_1$  和  $C_2$  的并联:



(第1题图)

$$\text{由 } C_1 = \frac{\epsilon_0 \frac{S}{2}}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{2d}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{2}}{d} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{2d},$$

$$\text{并联后总电容: } C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} + \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{2d} = \frac{(1 + \epsilon_r) \epsilon_0 S}{2d}. \quad \text{本题选 (C)}$$

2. 平行板电容器充电后仍与电源相连, 则两板间电压为电源电压  $U$ , 保持不变。

$$\text{真空平行板电容器的电容为 } C = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \text{ 则板上电荷电量: } Q = CU = \frac{\epsilon_0 S}{d} U;$$

$$\text{两板间电场强度大小: } E = \frac{U}{d}; \text{ 电场能量: } W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} U^2.$$

保持与电源相连, 电压  $U$  不变, 增大两板之间的距离  $d$ , 则板上电荷电量  $Q = \frac{\epsilon_0 S}{d} U$  减少,

$$\text{电场强度 } E = \frac{U}{d} \text{ 减小, 电场能量 } W_e = \frac{\epsilon_0 S}{2d} U^2 \text{ 减小.} \quad \text{本题选 (B)}$$

3. 电容器  $C_1$  和  $C_2$  串联后加上 1000V 电压, 即  $U_1 + U_2 = 1000 \text{ V}$ ;

电容器  $C_1$  和  $C_2$  串联, 则  $C_1$  和  $C_2$  上的电量相等, 即  $C_1 U_1 = C_2 U_2$ ;

$$\text{联立 } \begin{cases} U_1 + U_2 = 1000 \text{ V} \\ 200 U_1 = 300 U_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = 600 \text{ V} \\ U_2 = 400 \text{ V} \end{cases},$$

由于  $U_1 = 600 \text{ V} > 500 \text{ V}$  (耐压值), 所以电容器  $C_1$  先被击穿;

$C_1$  先被击穿后, 1000V 电压加在  $C_2$  上,  $1000 \text{ V} > 900 \text{ V}$  (耐压值), 电容器  $C_2$  也被击穿。 本题选 (C)

4. 真空平行板电容器电容为  $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ , 插入  $\frac{S}{2}$  的电介质后电容为  $C = \frac{(1 + \epsilon_r) \epsilon_0 S}{2d}$ , (由第 1 题可得)

$$\text{电容之比: } \frac{C}{C_0} = \frac{\frac{(1 + \epsilon_r) \epsilon_0 S}{2d}}{\frac{\epsilon_0 S}{d}} = \frac{1 + \epsilon_r}{2}.$$

5. 真空平行板电容器电容为  $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ , 接到电源上, 电源电压为  $U$ , 保持不变, 则电场能量:  $W_0 = \frac{1}{2} C_0 U^2$ ;

若在电容器中充满相对电容率为  $\epsilon_r$  的电介质, 则平行板电容器的电容为  $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$ , 电源电压仍然为  $U$ ,

$$\text{则此时电场能量: } W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 U^2, \text{ 所以有: } \frac{W}{W_0} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_r C_0 U^2}{\frac{1}{2} C_0 U^2} = \epsilon_r.$$

6. 真空平行板电容器电容为  $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ , 接到电源上, 电源电压为  $U$ , 保持不变, 则电场能量:  $W_0 = \frac{1}{2} C_0 U^2$ ;

若在电容器中充满相对电容率为  $\epsilon_r$  的电介质, 则平行板电容器的电容为  $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$ , 电源电压仍然为  $U$ ,

$$\text{则此时电场能量: } W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 U^2, \text{ 所以 } \frac{C}{C_0} = \frac{\frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}}{\frac{\epsilon_0 S}{d}} = \epsilon_r, \quad \frac{W}{W_0} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_r C_0 U^2}{\frac{1}{2} C_0 U^2} = \epsilon_r.$$

7. 假设真空中孤立的球体和球面半径都为  $R$ , 带电量为  $Q$ , 由于电荷均匀分布, 空间电场具有球对称性。

(1) 均匀带电球体的电场分布: 球体把空间分成两个区域, 在各区域内作一半径为  $r$  的同心球面  $S$  做为高斯面。

$$r > R \quad \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} Q \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2};$$

$$r < R \quad \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{Q}{R^3} r^3 \Rightarrow E = \frac{Qr}{4\pi \varepsilon_0 R^3};$$

(2) 均匀带电球面的电场分布: 球面把空间分成两个区域, 在各区域内作一半径为  $r$  的同心球面  $S$  做为高斯面.

$$r > R \quad \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} Q \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2};$$

$$r < R \quad \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} 0 \Rightarrow E 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0;$$

根据以上计算发现, 球体和球面外部区域 ( $r > R$ ) 电场分布相同, 外部区域电场能量相等; 球面内部没有电场, 没有电场能量, 但球体内有电场, 有电场能量。所以球体的静电场总能量大于球面的静电场总能量。

8. 设半径为  $R_1$  的铜导线单位长度的电量 (电荷线密度) 为  $\lambda$ , 则外导体铜箔在半径为  $R_2$  的内表面上感应出电荷线密度为  $-\lambda$  的电荷。在介质中作一半径为  $r$ , 高为  $h$  的圆柱面作为高斯面, 由  $\vec{D}$  的高斯定理:

$$R_1 < r < R_2, \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \lambda h \Rightarrow D \cdot 2\pi r h = \lambda h \Rightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r};$$

$$\text{由 } D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E \Rightarrow \text{电介质中的电场强度大小: } E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r};$$

$$\text{在 } R_1 < r < R_2 \text{ 介质范围中, } r = R_1 \text{ 时, 介质中场强最大: } E(R_1) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 R_1} \leq E_{\max}, \Rightarrow \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \leq E_{\max} \cdot R_1;$$

$$\text{电缆承受的电压: } U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} \leq E_{\max} \cdot R_1 \cdot \ln \frac{R_2}{R_1},$$

$$(1) \text{ 电缆能够承受的最高电压: } U_{\max} = E_{\max} \cdot R_1 \cdot \ln \frac{R_2}{R_1};$$

(2) 当电压升高时, 介质中半径为  $R_1$  处先被击穿;

(3) 题目有些问题, 应该指明在什么条件 (铜导线的电荷线密度) 下电缆中存储的静电场能量。

$$9. \text{ 图 (a) 中, 电容器两端电压 } U_0 \text{ 不变, 初始电容 } C_0 = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}, \text{ 初始静电场能量: } W_0 = \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{2d} U_0^2;$$

$$\text{拉出电介质后电容 } C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \text{ 静电场能量: } W = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} U_0^2, \text{ 静电场能量变小。}$$

$$\text{图 (b) 中, 电容器存储电荷 } Q = C_0 U_0 \text{ 不变, 初始静电场能量: } W_0 = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{1}{2} C_0 U_0^2 = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{2d} U_0^2;$$

$$\text{拉出电介质后, 静电场能量: } W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2C} C_0^2 U_0^2 = \frac{\varepsilon_r^2 \varepsilon_0 S}{2d} U_0^2 > W_0 = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{2d} U_0^2, \text{ 静电场能量变大。}$$